

Specyfikacja.

L.p.		Nazwa produktu	Specyfikacja	numer	ilość
1	Induktor_1	Inductor	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa 0201(dł=0.6mm/wys=0.3mm/szer=0.3mm) - indukcyjność L = 1.0nH(+/-0.3nH) - prąd maks. I_{max} = 300mA - produkt bezołowiowy - parametr SRF >21GHz - dobroć Q_{min} = 4(100MHz) - temp. pracy -55stC/+100stC 	L-05B1N0SV6T	100
2	Kondensator_1	Capacitor	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa 0402(dł=1.0mm/wys=0.4mm/szer=0.55mm) - pojemność C = 0.5pF(+/-0.01pF) - napięcie U_{cmax} = 100V - spełnia wymogi tech. wys. częstotliwości - produkt bezołowiowy - temp. pracy -55stC/+125stC 	04021J0R5ZBSTR	50
3	Kondensator_2	Capacitor	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa 0402(dł=1.0mm/wys=0.4mm/szer=0.55mm) - pojemność C = 1.5pF(+/-0.05pF) - napięcie U_{cmax} = 25V - spełnia wymogi tech. wys. częstotliwości - produkt bezołowiowy - temp. pracy -55stC/+125stC 	04023J1R5ABSTR	50
4	Wzmacniacz_1	Differential Amplifier	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa UQFN 14-pin (2.50mmx2.50mm) - nap. zasilania V_s = 3.3V - 5.0V - niski pobór mocy (55mA) - szerokość pasma GBP = 8GHz; czułość G = 30dB(32V/V); GBP = 6.2 GHz(V_o=200mVpp; -3dB) - nap. wejściowe (V_{S-})= -0.7V/(V_{S+}) = 0,7V - wysoka prędkość narastania syg. 17500V/us - impedancja wejściowa Z_{in} = 4,6kOhm - impedancja wyjściowa minZ_o = 16Ohm - niskie zniekształcenia harmoniczne 1GHz -> HD2 -64dBc/HD3 -58dBc - niskie wejściowe napięcie szumów 1.25nV/sqrt(Hz) - niski wejściowy prąd szumów 3.5pA/sqrt(Hz) - temp. pracy -40stC/85stC 	LMH5401IRMST	5

5	Złącze_1	SMA Connector	<ul style="list-style-type: none"> - 27GHz - złącze mikrofalowe/ typ: gniazdo/profil płaski wym.: (śr. izolatora 0.0635"/śr. pinu wew. 0.02"/ śr. pinu montażowego 0.01") - styk wykonany z BeCu - izolator wykonany z fluorowęgla PTFE - kołnierz gwintowy wykonany ze stali - niklowany zacisk złącza 	End Launchers / manufacturer's only available	25
6	Rezystor_1	Chip Resistor	<ul style="list-style-type: none"> - rezystancja 100Ohm (+/-5%) - moc strat $P_{tot} = 0.1W$ - współczynnik temperaturowy (+/- 100ppm/stC) - wysokojakościowy korpus ceramiczny - laserowa korekta wartości rezystancji - obudowa SMT 0603(1.6mmx0.8mmx0.45mm) 	100 ohm	100
7	Dioda_6	Schottky diode	<ul style="list-style-type: none"> - napięcie zaporowe $V_{max} = 30V$ - prąd przewodzenia $I_{max} = 100mA$ - prąd wsteczny $I_r = 10uA$ - niskie napięcie przewodzenia $V_f = 0.34V$ - produkt bezołowiowy - obudowa SOD523F {0603(1.6mmx0.8mmx0.45mm)} - złoczone piny lutownicze 	CDBU0130L	25
8	Wzmacniacz_3	Broadband Amplifier	<ul style="list-style-type: none"> - wzmacniacz niskoszumny $NF = 1.8dB$ - czułość $G = 15dB$ - sygnał wyjściowy $IP_3 = +25dBm$ - impedancja wej/wyj $Z_{in/out} = 50Ohm$ - szeroki zakres częstotliwości 2-12GHz - zależność czułości od temperatury 0.01 dB/stC - niski pobór mocy $V_s = 4V/I_s = 45mA$ - obudowa aluminium SOT(4mmx4mm)/24piny(złoto/nikiel) 	HMC772	2
9	Mixer_1	Mixer	<ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 3 Ghz - 9Ghz - moc strat 1044 mW - sygnał wyjściowy $IP_3 = +24dBm(3-9GHz)$ - technologia MESFET(półprzewodniki GaAs) - separacja (LO/IF) wew. oscylatora do syg. wys. częst. 43dB - nie wymaga peryferyjnych komponentów - obudowa E-12-4(ceramiczno-aluminiowa, bezołowiowa, 12pinów(złoto/nikiel)) - temp. pracy -40stC/+85stC 	HMC787ALCB	4

10	Tranzystor_1	RF transistor	<ul style="list-style-type: none"> - tranzystor NPN, obudowa SOT89 - wysoka częstotliwość pracy fT = 10.5GHz - niskoszumny NFmin = 0.75dB - napięcie kolektor-emiter Vcemax = 24V - prąd kolektora Icmx = 60mA - moc strat Ptot = 1000mW - niska pojemność kolektora Cc = 1.1pF - czułość Gp(max) = 14dB 	BFU580Q	25
11	Piezo_1	Piezoelectrical sensor	<ul style="list-style-type: none"> - napięcie wyjściowe Vomin=100mV/Vomax=100V - impedancja obciążenia min. 1MΩ - elastyczna obudowa/"plaster" wykonany z Mylar'u - czułość na wstrząsy, uderzenia, naprężenia mechaniczne - wyprowadzone przewody 	LDT1-028K	5
12	Dioda_3	Varactor Diode	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa SOD-323 - napięcie zaporowe Vrmx = 10V - niski prąd wsteczny Irmx = 10nA(Vr = 10V) - prąd przewodzenia Ifmax = 20mA - niska rezystancja złącza Rs = 0.4 Ω - poj. złącza Ctmin=4.2pF/Ctmax=17.60pF/stosunek: 3.30 - temp. pracy -55stC -> +125stC 	BB156	25
13	Dioda_4	PIN Diode	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa SOD-323 - napięcie zaporowe Vrmx = 30V - niski prąd wsteczny Irmx = 20nA(Vr = 20V) - prąd przewodzenia Ifmax = 100mA - czas przełączania tL = 0.17us - separacja syg. 10.2dB przy 900MHz - moc strat Pdismx = 500mW - poj. złącza Ct < 1 pF - temp. pracy -65stC -> +150stC - temp. przechowywania -65stC -> +150stC 	BAP65-03	100